【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【公開番号】特開2010-103563(P2010-103563A)
【公開日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2010-018
【出願番号】特願2010-18432(P2010-18432)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/8246　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/112　(2006.01)
Ｇ１１Ｃ　16/04　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/10　４３３
Ｇ１１Ｃ　17/00　６２３Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月31日(2010.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】超薄膜誘電体のブレークダウン現象を利用した半導体メモリセル及びメモリアレイ